

InGaAs PIN фотодиод 2200 нм, 1000 мкм (AG), TO-46 — техническое описание

P/N : WIT4-1000L

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая чувствительность
- Низкий темновой ток
- Спектральная чувствительность 900–2200 нм

ПРИМЕНЕНИЕ

Датчики CO2; оптические датчики; измерители оптической мощности; измерение спектральной чувствительности

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	ψ		-	1000	-	мкм
Темновой ток	Id	Vr=-0.5V	-	-	9	мкА
Чувствительность	R	Vr=0V,@2000 nm	-	1.2	-	А/Вт
		Vr=0V,@1650 nm	-	1.2	-	А/Вт
		Vr=0V,@1550 nm	-	1	-	А/Вт
Емкость	Cp	Vr=0V, f=1MHz	-	440	1000	пФ
Рабочий диапазон длин волн	λ		900	2004	2200	нм
Линейная мощность насыщения	Ps	Vr=0V	2	-	-	мВт

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Рабочая температура	от -40 °C до +85 °C
Температура хранения	от -40 °C до +120 °C
Линейная мощность насыщения	2mW
Температура пайки	260 °C
Время пайки	10S

Габаритный чертёж (ед.: мм)

